



اثر حضور نانو خوشه‌های مس به عنوان زیرلایه بر خواص بلوری و نوری لایه دی-اکسیدتیتانیوم

علی اصغر خاکپور^۱، کامران احمدی^{۱،۲}، قاسم کاوهای^{۱*}

۱- پژوهشگاه نیمه هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

۲- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران، تهران، ایران

(دریافت مقاله: ۹۶/۸/۲۴)

چکیده: دو نمونه از نانو خوشه‌های مس روی بسترهاي از کوارتز با ضخامت ۱۰ نانومتر و ۲۰ نانومتر رشد داده شدند. هر نمونه با یک لایه دی-اکسیدتیتانیوم به ضخامت ۳۰۰ نانومتر پوشش داده شد. برای مقایسه لایه دی-اکسیدتیتانیوم با ضخامت ۳۰۰ نانومتر روی بسترهاي کوارتز نيز لایه‌شانی شدند. همه لایه‌ها به روش رسوب‌دهی فیزیکی بخار (PVD) و با استفاده از دستگاه لایه‌شانی با باریکه الکترونی (EBD) تهیه شدند. اثر نانو خوشه‌های مس بر ریخت‌شناسی سطح، اندازه دانه‌ها، مرزدانه‌ها، ساختار و فازهای بلوری و برخی از خواص نوری مانند جذب و عبور لایه دی-اکسیدتیتانیوم بررسی شدند. ریخت‌شناسی سطح لایه‌ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و ساختار بلوری لایه‌ها و تبدیل‌های فازی در اثر عملیات گرمایی با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شدند. از طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی برای تجزیه و تحلیل جذب و عبور لایه‌های دی-اکسیدتیتانیوم استفاده شد. حضور نانو خوشه‌های مس به عنوان زیر لایه باعث افزایش زیر لایه‌های TiO_2 و تسهیل تبدیل فاز آناتاز به روتیل در این لایه‌ها می‌شود. علاوه بر این در حضور زیر لایه نانو خوشه‌های مس، گاف انرژی لایه TiO_2 کاهش می‌باید و جذب نوری آن در ناحیه مرئی بهبود می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: نانو خوشه‌های مس؛ دی-اکسیدتیتانیوم؛ جذب؛ عبور؛ گاف انرژی.

افزایش بازده فتوکاتالیزوری در گستره نور مرئی یکی از زمینه‌های پژوهشی داغ و جذاب برای پژوهشگران است [۸]. یکی از روش‌های مناسب برای اصلاح خواص نوری نانولایه‌های دی-اکسیدتیتانیوم، آلایش آن با عناصر فلزی و غیرفلزی به منظور افزایش واکنش‌های انتقال بار و پایداری گرمایی فتوکاتالیزور است [۹]. به عنوان مثال، لی و همکارانش با روش غوطه‌وری دریافتند که فعالیت فتوکاتالیزوری دی-اکسیدتیتانیوم آلاییده شده با تنگستن در مقایسه با آلومینیوم بهتر است [۱۰]. دومردکی و همکارانش تأثیر آلاینده‌های Tb و Pd بر لایه TiO_2 نهشته شده به روش کندوپاش را روی زیرلایه‌ی

مقدمه در حال حاضر دی-اکسیدتیتانیوم (TiO_2) به دلیل خواص نوری، پایداری گرمایی، فعالیت فتوکاتالیزوری بالا و ارزان بودن آن نسبت به مواد دیگر، به عنوان یک فتوکاتالیزور آرمانی توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است [۱، ۲]. دی-اکسیدتیتانیوم بیشتر در سه فاز بلوری آناتاز، روتیل و بروکیت وجود دارد که از میان آنها فاز بروکیت بسیار نادر است. از نظر فعالیت فتوکاتالیزوری بیشتر فازهای آناتاز و روتیل فعال بوده و به ترتیب دارای گاف انرژی 3.2 eV و 3.05 eV هستند [۷-۳]. به همین دلیل فتوکاتالیزور دی-اکسیدتیتانیوم بیشتر در گستره نور فرابنفش فعال است و اصلاح خواص نوری آن به منظور

اندازه دانه‌ها میتوان از روش‌های مختلفی مانند کنترل شرایط لایه نشانی از جمله سرعت لایه نشانی، دمای زیر لایه، استفاده از کاتالیزورها و غیره بهره برد. با کنترل ساختار زیرلایه نیز میتوان زیری سطح لایه و خواص آن را کنترل کرد. بنابراین در این پژوهش راهکار جدیدی برای کنترل خواص لایه TiO_2 با استفاده از حضور نانوخرشنهای مس به عنوان زیرلایه ارائه شده و تاثیر حضور این زیر لایه بر ریخت‌شناسی سطح نانو لایه دی-اکسیدتیتانیوم، اندازه و مرزبندی دانه‌ها، ساختار و فاز بلوئی لایه و خواص نوری آن از جمله عبور و جذب بررسی می‌شود.

مواد و روش‌ها تهیه لایه‌ها

در این پژوهش از مس و پودر دی‌اکسیدتیتانیوم شرکت سیگما درجه با خلوص ۹۹٪ استفاده شد. نخست از حل کردن ۵٪ گرم پودر پلی وینیل الکل (PVA) در ۲۰ میلی لیتر آب دو بار تقطیر یک محلول چسب تهیه شد که آنرا محلول A می‌نامیم. پودر دی‌اکسیدتیتانیوم به همراه ۳ گلوله زیرکونیا به قطر ۱۰ میلی‌متر برای مدت ۳ ساعت درون محفظه زیرکونیا آسیاب شد. محلول A به پودر دی‌اکسیدتیتانیوم افروده شد و به مدت ۱۵ دقیقه ورز داده شد تا مخلوط خمیری شکلی به دست آید. خمیر حاصل به مدت ۲۴ ساعت در هوای محیط خشک گردید و سپس با استفاده از دستگاه پرس در قالبی به قطر ۷ میلی‌متر و ضخامت ۱۰ میلی‌متر به قرص تبدیل شد.

قرص‌های تهیه شده در دستگاه لایه‌نشانی باریکه الکترونی (EBD) مدل 306 Auto ساخت شرکت ادواردز مجهز به ضخامت سنج بلوئی قرار داده شد و در ادامه با برخورد باریکه‌های الکترونی پرانرژی ذرات آن به شکل بخار درآمده و روی بستر لایه نشانی شدند. در اصل این نوع لایه نشانی از نوع رسوبدی فیزیکی بخار (PVD) است. زیر لایه‌های از جنس کوارتز به ابعاد $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ کاملاً تمیز و چربی زدایی شدند. فرآیند لایه نشانی در دمای محیط و در فشار 10^{-5} Pa انجام شد. نخست ماسک ساخته شده از توری دستگاه TEM روی زیر لایه کوارتز قرار داده شد. سپس نانو خوشنهای مس به ضخامت‌های $10 \pm 2\text{ nm}$ و $20 \pm 2\text{ nm}$ روی زیر لایه کوارتز نشانده شده و در ادامه لایه‌هایی از دی‌اکسیدتیتانیوم به ضخامت $300 \pm 25\text{ nm}$ روی نانوخرشنهای نهشته شدند. همچنین

سیلیکون و شیشه بررسی کردند و نشان دادند که آلایش همزمان آنها بر خواص نوری و الکتریکی TiO_2 تاثیر بیشتری دارد [۱۱]. همچنین گزارش‌هایی از آلایش فلزات نجیب مثل Cu، Ag و Au به منظور بررسی خواص نوری TiO_2 منتشر شده است [۴]. بررسی‌های انجام شده پیرامون آلایش دی-اکسیدتیتانیوم با فلز مس (Cu) که به روش‌های مختلفی از جمله کندوپیاش و غوطه وری انجام شده است نشان می‌دهند که آلایش مس در ساختار بلوئی TiO_2 به روش‌های لایه نشانی فیزیکی، و در بعضی موارد شیمیایی، تاثیر چندانی بر خواص نوری و فوتوكاتالیزوری دی‌اکسیدتیتانیوم ندارد [۱۲]. اما روش سل-زل اصلاح شده تا حدی می‌تواند اثر آلایش مس بر خواص نوری و فوتوكاتالیزوری دی‌اکسیدتیتانیوم را نشان دهد [۱۳-۲۰].

روش‌های مختلفی برای تهیه لایه نازک TiO_2 توسعه یافته است که مهمترین آنها عبارتند از سل-زل [۲۱، ۲۲]، لایه نشانی با پرتو لیزری [۲۳]، تجزیه گرمایی افسانه‌ای [۵، ۶، ۲۴، ۲۵]، تجزیه گرمایی افسانه‌ای به کمک امواج فرا صوت [۶، ۲۱، ۲۴]، گرمایی [۲۶]، کندوپیاش [۲۷]، رسو بخار شیمیایی [۲۸]، و لایه‌نشانی باریکه الکترونی [۲۹]. از میان آنها، روش‌ها شیمیایی گرچه آسان و کم هزینه هستند و نیاز به تجهیزات گران قیمت ندارند، اما کنترل فرآیند در این روش‌ها برای دستیابی به فراورده‌هایی با کیفیت بالا چندان آسان نیست و اغلب فراورده‌هایی با یکنواختی پائین با این روش‌ها تولید می‌شوند. اما روش‌های فیزیکی گرچه نیازمند تجهیزات گران هستند و بازده تولید فراورده چندان بالایی ندارند، اما به دلیل قابلیت کنترل دقیق فرآیند تولید، فراورده‌های با کیفیت و یکنواختی بالا تولید می‌کنند. روش لایه‌نشانی باریکه الکترونی از جمله روش‌های فیزیکی تولید لایه‌های نازک نانوساختار است که با برخورد الکترون‌های پرانرژی به سطح ماده مورد نظر ذرات آن را کنده و بخار ذرات حاصل در ادامه روی بستر مناسب لایه نشانی می‌شوند و در این روش فراورده‌های با کیفیت بالا تولید می‌شوند.

یکی از عوامل موثر بر میزان آبدوستی و آبگریزی سطح لایه‌ها، زیری سطح لایه و اندازه دانه‌های تشکیل دهنده سطح است به طوری که از طریق کنترل این عوامل می‌توان میزان آبدوستی سطح را کنترل کرد [۳۰، ۳۱]. به منظور کنترل

HR4000 ساخت شرکت اوشن اپتیک بررسی گردید.

بحث و بررسی

ریخت‌شناسی نانوخوشهای مس

در شکل ۱ تصاویر FE-SEM با بزرگنمایی‌های متفاوت از نانوخوشهای مس به ضخامت ۱۰ و ۲۰ نانومتر به ترتیب در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است. این شکل‌ها رشد نانوخوشهای مس روی زیر لایه را به خوبی نشان می‌دهند. همچنان که در شکل ۲ دیده می‌شود این نانوخوشهای رشد کرده و بزرگتر شده‌اند و بعضی از آنها به هم متصل شده و تشکیل جزیره‌هایی داده‌اند، اما یک لایه یکنواخت و همگن ایجاد نشده است. علاوه بر این چنان که تصاویر شکل‌های ۱ و ۲ نشان می‌دهند با افزایش ضخامت لایه از ۱۰ نانومتر به ۲۰ نانومتر، زبری لایه افزایش می‌یابد.

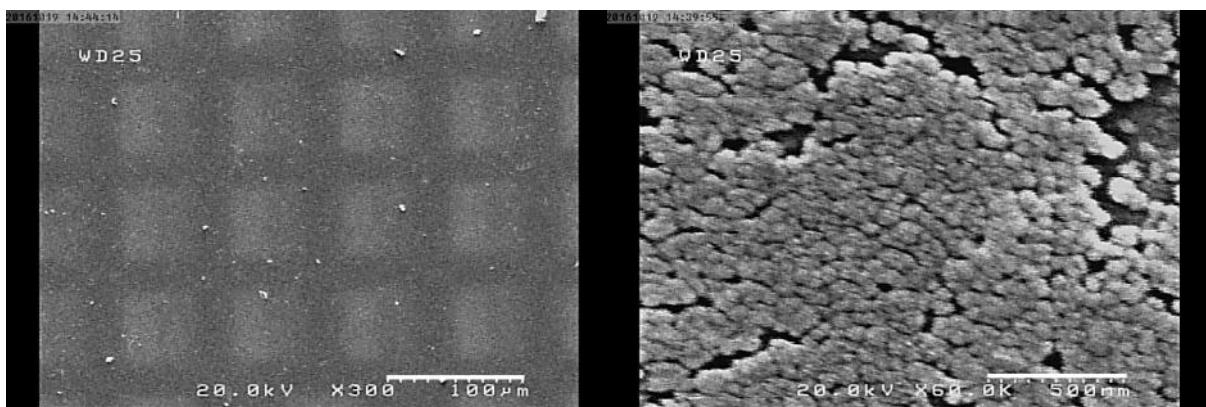
برای مقایسه یک لایه دی‌اکسیدتیتانیوم به ضخامت 25 ± 300 nm نیز مستقیم روی زیر لایه کوارتز نشانده شد. به منظور بررسی اثر عملیات گرمایی، نمونه‌های تهیه شده، در دماهای 400°C ، و 700°C به مدت ۳ ساعت گرمادهی شدند. در جدول ۱ خلاصه‌ای از شرایط تهیه نمونه‌ها آمده است.

مشخصه‌یابی لایه‌های تهیه شده

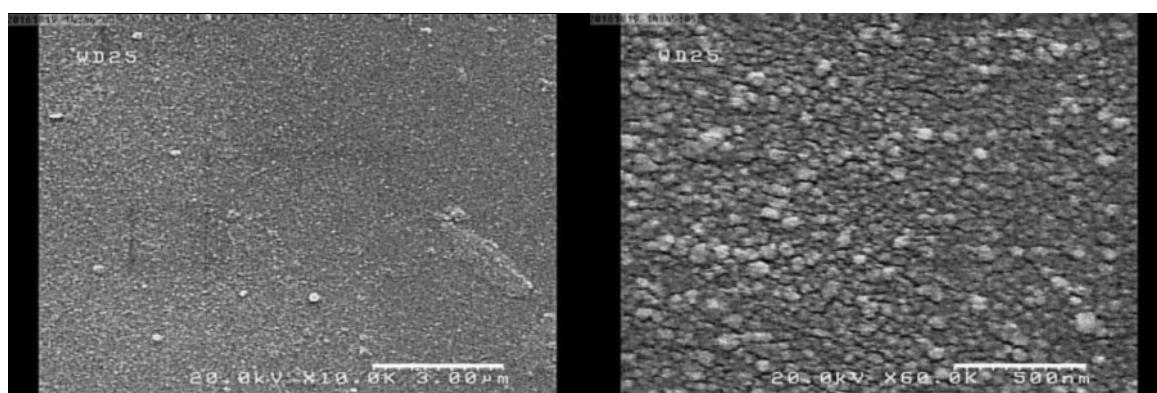
شکل ظاهری (ریخت‌شناسی) لایه‌های تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی (FE-SEM) مدل S-4160 ساخت شرکت هیتاچی بررسی شدند. طرح پراش پرتو X PW1730 (XRD) از نمونه‌ها توسط دستگاه XRD مدل PW1730 از نمونه‌ها با طول موج $\text{Cu}_{\text{K}\alpha}$ ۰.۱۵۴۰۵۶ nm تهیه شد. طیف جذبی و عبوری لایه‌های تهیه شده با استفاده از دستگاه طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی مدل

جدول ۱ نمونه‌های تهیه شده در شرایط مختلف.

عملیات گرمایی	ضخامت TiO_2	ضخامت لایه نانوخوشهای مس	نمونه
بدون عمیات گرمایی	۳۰۰ نانومتر	فاقد لایه مس	A ₁
400°C	۳۰۰ نانومتر	فاقد لایه مس	A ₂
700°C	۳۰۰ نانومتر	فاقد لایه مس	A ₃
بدون عمیات گرمایی	۳۰۰ نانومتر	۱۰ نانومتر	B ₁
400°C	۳۰۰ نانومتر	۱۰ نانومتر	B ₂
700°C	۳۰۰ نانومتر	۱۰ نانومتر	B ₃
بدون عمیات گرمایی	۳۰۰ نانومتر	۲۰ نانومتر	C ₁
400°C	۳۰۰ نانومتر	۲۰ نانومتر	C ₂
700°C	۳۰۰ نانومتر	۲۰ نانومتر	C ₃



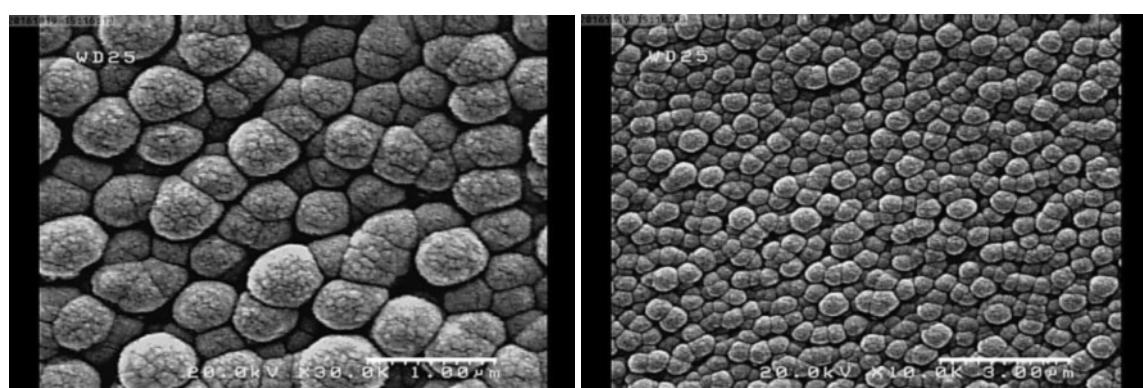
شکل ۱ تصاویر FE-SEM از نانوخوشهای مس به ضخامت ۱۰ نانومتر در دو بزرگنمایی (الف) ۶۰۰۰ و (ب) ۳۰۰ برابر.



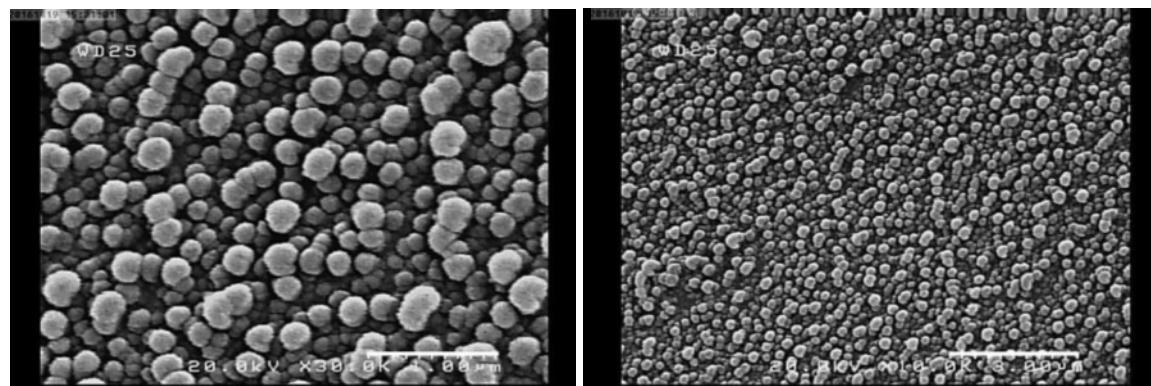
شکل ۲ تصاویر FE-SEM از نانوخرشنهای مس به ضخامت ۲۰ نانومتر در دو بزرگنمایی (الف) ۱۰۰۰۰ و (ب) ۶۰۰۰۰ برابر.

افزایش داد. دلیل افزایش زبری در نمونه C₁ را در واقع می‌توان القاء زبری زیرلایه نانوخرشنهای مس بر لایه نهایی تشکیل یافته دانست. زیرا چنان که در مورد تصاویر مربوط به نانوخرشنهای مس بیان شد، لایه نانوخرشنهای مس با ضخامت ۱۰ نانومتر زبری بیشتری دارد. بنابراین با کنترل زبری زیرلایه، زبری لایه نهایی قابل کنترل است که آن نیز به نوبه خود بر خواص لایه مانند میزان آبدوستی یا آبگریزی آن تاثیرگذار خواهد بود.

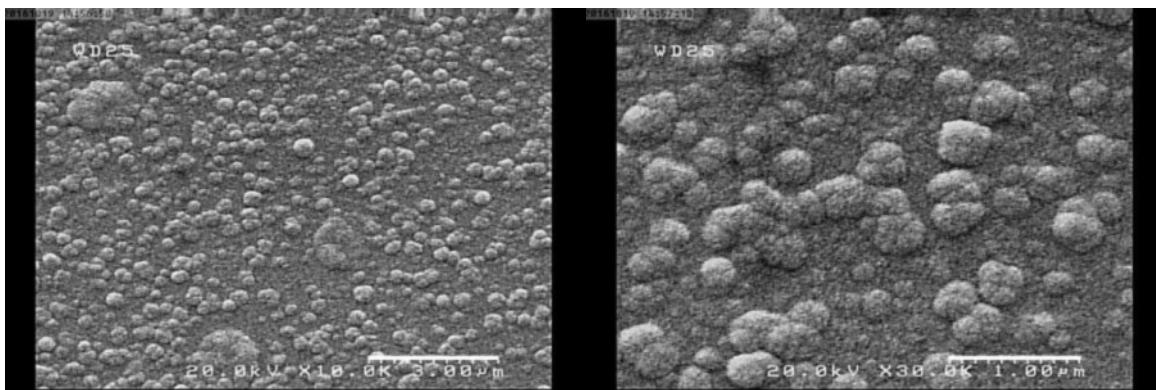
ریخت‌شناسی لایه‌های TiO₂ از نمونه‌های A₁, B₁, A₁ و C₁ تصاویر FE-SEM تهیه شد که به ترتیب در شکل‌های ۴، ۳ و ۵ دیده می‌شوند. این شکل‌ها نشان می‌دهند که ساختار لایه‌ها بلوری با دانه‌هایی تقریباً کروی شکل و یکنواخت است که مرزیندی دانه‌ها به خوبی مشاهده می‌شود. لایه‌ها متراکم هستند اما زبری سطح لایه‌ها در نمونه B₁ از نمونه A₁ و همچنین نمونه C₁ از A₁ و B₁ بیشتر است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با لایه نشانی نانوخرشنهای مس روی زیرلایه کوارتز و با کنترل ضخامت آن پیش از لایه نشانی TiO₂ می‌توان زبری سطح لایه TiO₂ را کنترل و



شکل ۳ تصاویر FE-SEM از نمونه A₁ در دو بزرگنمایی (الف) ۱۰۰۰۰ و (ب) ۳۰۰۰۰ برابر.

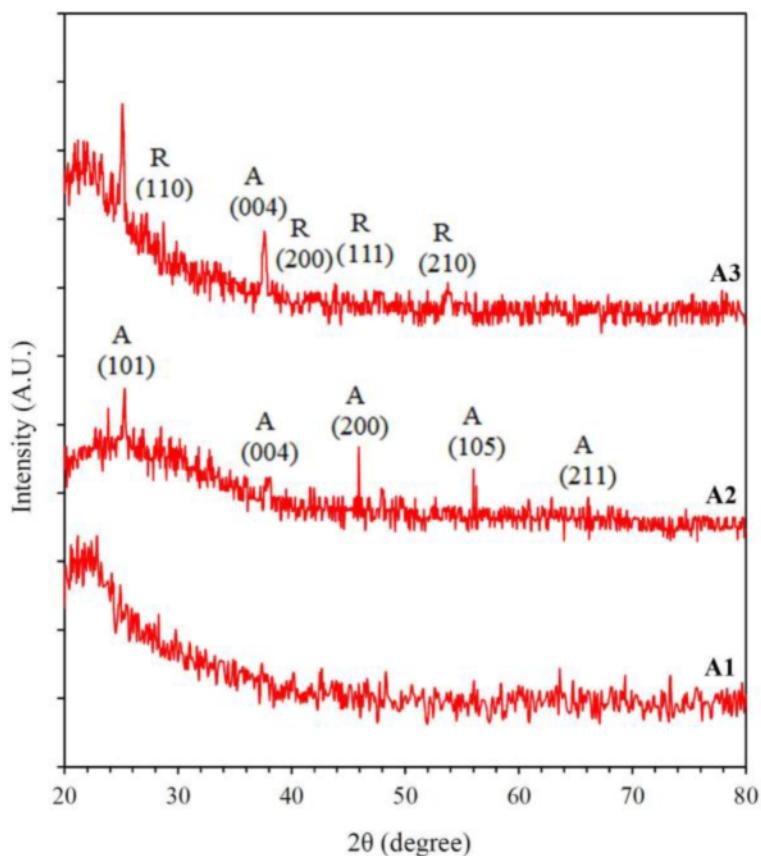


شکل ۴ تصاویر FE-SEM از نمونه B₁ در دو بزرگنمایی (الف) ۱۰۰۰۰ و (ب) ۳۰۰۰۰ برابر.

شکل ۵ تصاویر FE-SEM از نمونه C₁ در دو بزرگنمایی (الف) ۳۰۰۰۰ و (ب) ۱۰۰۰۰ برابر.

فازی شروع می‌شود به گونه‌ای که در دمای ۷۰۰ °C (نمونه A₃) فازهای روتیل هرچند به صورت ضعیف ظاهر می‌گردند و مقدار فاز آناتاز کاهش می‌یابد. می‌توان پیش بینی کرد که با عملیات گرمایی در دماهای بالاتر تبدیل فاز از آناتاز به روتیل کامل می‌شود. این رفتار در اثر گرمادهی ویژگی لایه‌های دی-اکسیدتیتانیوم است که در بسیاری از مراجع به آن اشاره شده است.

تحلیل پراش پرتو X
شکل ۶ طرح‌های XRD نمونه‌های A₁, A₂ و A₃ را نشان می‌دهد. دیده می‌شود که لایه تهیه شده در دمای محیط که عملیات گرمایی برای آن انجام نشده است (A1) فاقد بلورینگی بوده و آمورف است. اما با عملیات گرمایی در ۴۰۰ °C (نمونه A₂) فازهای بلوری آن تشکیل شده‌اند که بیشتر فاز آناتاز هستند. با ادامه‌ی عملیات گرمایی در دماهای بالاتر، تبدیل

شکل ۶ طیف پراش پرتو X (XRD) از نمونه‌های A₁, A₂ و A₃ که در آن A و R به ترتیب نشان دهنده فاز آناتاز و روتیل است.

جذب نوری نمونه‌های A₁ و A₂ را نشان می‌دهد. چنان‌که دیده می‌شود، میزان جذب نوری لایه‌ها در ناحیه‌ی مرئی تقریباً ناچیز است، هرچند با افزایش دمای عملیات گرمایی و طی تبدیل فاز از آناتاز به روتیل اندکی افزایش می‌یابد.

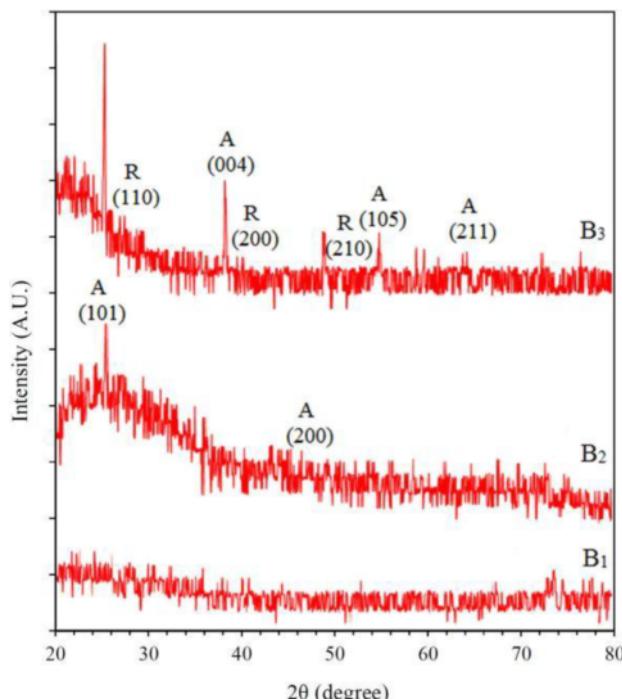
در شکل ۹ ب طیف جذب نوری نمونه‌های B₁، B₂ و B₃ در شکل ۹ پ طیف مربوط به نمونه‌های C₁، C₂ و C₃ نشان داده شده است. دیده می‌شود که با افزایش دمای عملیات گرمایی لایه‌های نازک دی‌اکسیدتیتانیوم در حضور نانوخوشه‌های مس، میزان جذب در ناحیه مرئی افزایش می‌یابد که رفتاری شبیه به نمونه‌های A₁ و A₂ (در غیاب نانوخوشه‌های مس) دارند (شکل ۹ الف). این افزایش در میزان جذب به دلیل تغییر ساختار بلوری و تبدیل فاز از آناتاز به روتیل بر اثر عملیات گرمایی است.

موضوع بسیار مهمی که از طیف جذبی نمونه‌ها در شکل ۹ به خوبی قابل مشاهده است، جایه‌جایی لبه‌ی جذب در لایه‌هاست که منجر به تغییر در گاف انرژی لایه‌ها می‌شود. با استفاده از معادله تاک که شکل کلی آن در رابطه (۱) آورده شده است می‌توان گاف انرژی لایه‌های تهیه شده را با دقت بالایی محاسبه نمود [۳۸، ۳۹]:

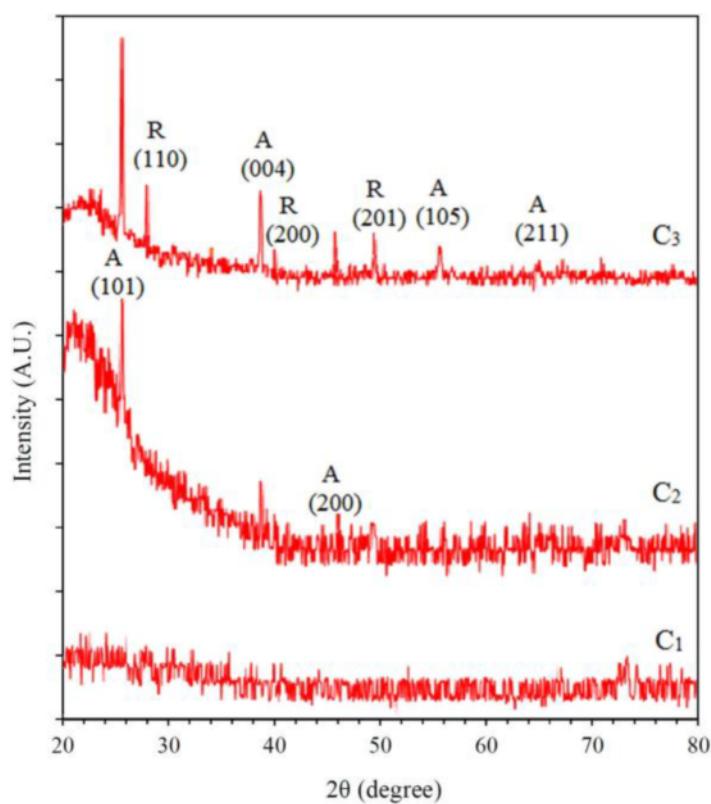
$$\alpha h\nu = A(\hbar\nu - E_g)^{n/2} \quad (1)$$

طیف پراش پرتو X نمونه‌های B₁، B₂ و B₃ در شکل ۷ و برای نمونه‌های C₁، C₂ و C₃ در شکل ۸ آورده شده است. از مقایسه شکل‌های ۶، ۷ و ۸ می‌توان نتیجه گرفت که در حضور نانو خوش‌های مس و همچنین با افزایش ضخامت آن در ساختار کلی طیف و ترکیب فازی آن تغییری ایجاد نشده است، اگرچه شدت قله‌های پراشی بیشتر شده و همچنین مقدار فاز روتیل نسبت به فاز آناتاز تقویت شده است. بنابراین حضور زیرلایه نانوخوشه‌های مس باعث تقویت بلورینگی لایه نهایی شده است همچنین تشکیل فاز روتیل را در عملیات گرمایی آسان می‌کند. همچنین در حضور نانوخوشه‌های مس و افزایش ضخامت آن پهنای قله‌ها کاهش یافته و در نتیجه با توجه به رابطه شرر اندازه بلورک‌ها افزایش یافته است. دلیل تسهیل تبدیل فازی آناتاز به روتیل در حضور زیرلایه نانوخوشه‌های مس را می‌توان افزایش زبری سطح و افزایش مرزدانه‌ها دانست، زیرا بر پایه مقالات موجود، مرزدانه‌ها محل تشکیل و رشد فاز روتیل از فاز آناتاز در عملیات گرمایی هستند و با افزایش آنها اینگونه تبدیل‌های فازی تسهیل می‌شود [۳۲-۳۷].

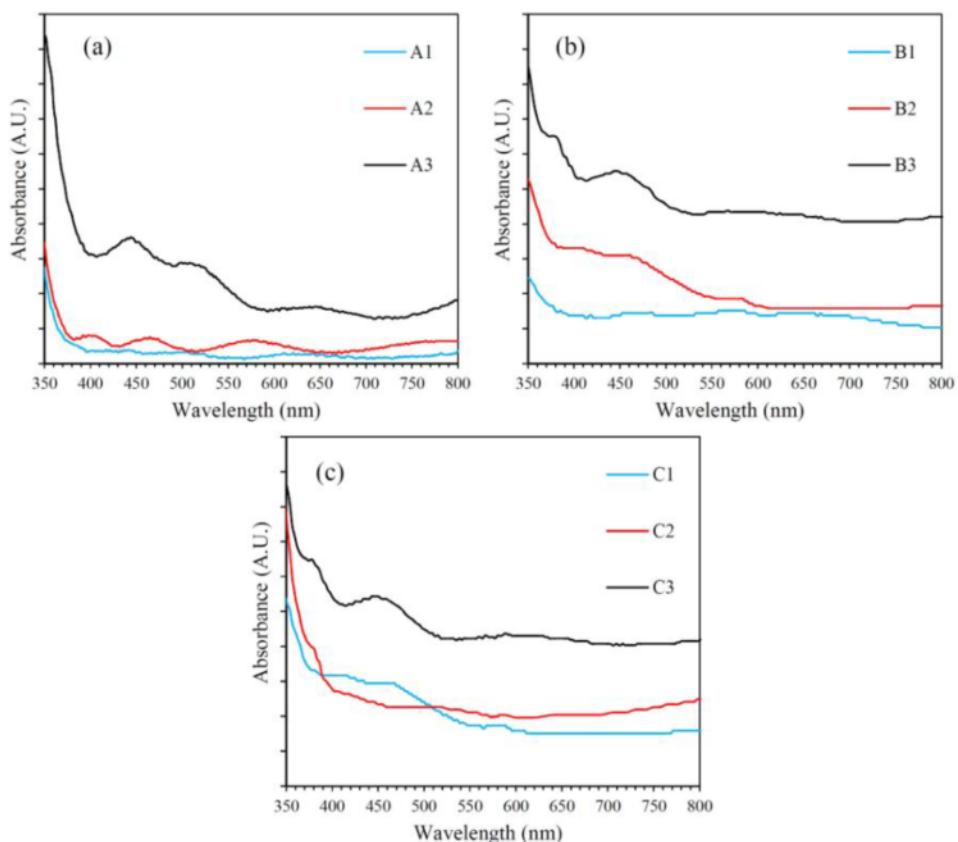
بررسی جذب و عبور نوری لایه‌های تهیه شده
برای بررسی میزان جذب و عبور نوری لایه‌های تهیه شده، طیف سنجی فرابنفش-مرئی برای آنها انجام شد. شکل ۹ الف



شکل ۷ طیف پراش پرتو X (XRD) از نمونه‌های B₁، B₂ و B₃



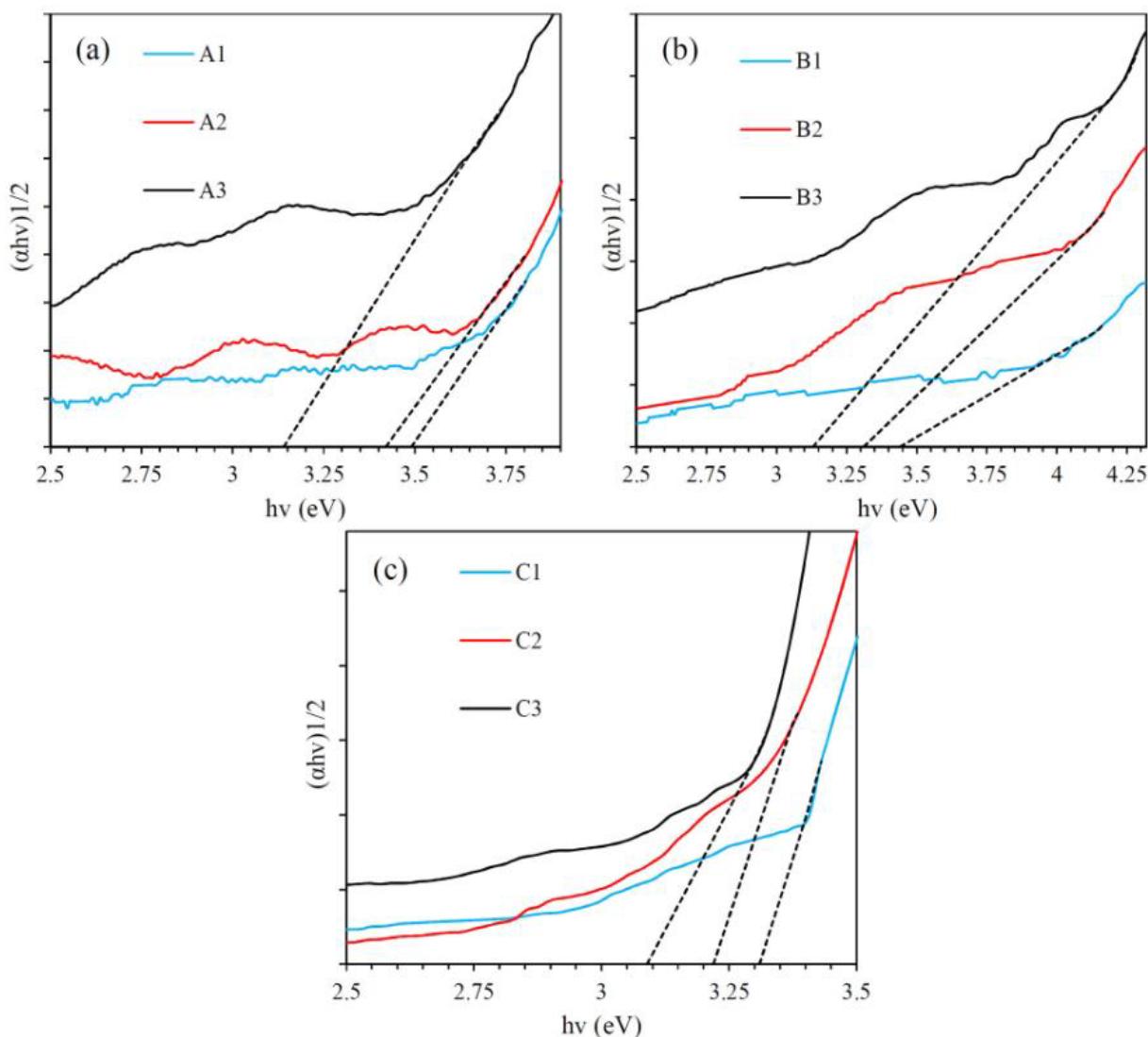
شکل ۸ طیف پراش پرتو X (XRD) از نمونه‌های C₁, C₂ و C₃



شکل ۹ طیف جذب نوری نمونه‌های تهیه شده.

A_3 کاهش می‌یابد. این رفتار با پژوهش‌های معتبر گزارش شده همخوانی کامل دارد زیرا با عملیات گرمایی فاز آناتاز با گاف انرژی بیشتر به فاز روتیل با گاف انرژی کمتر تبدیل می‌شود [۳۷، ۳۶]. همچنین نتایج بیان کننده جابه‌جایی لبه جذب به سمت ناحیه مریب و کاهش گاف انرژی در حضور نانو لایه مس میانی است. این جابه‌جایی لبه جذب با افزایش ضخامت نانو لایه مس و همچنین با افزایش دمای عملیات گرمایی لایه‌ها بیشتر می‌شود. کاهش گاف انرژی با افزایش دمای عملیات گرمایی به دلیل تبدیل فاز بلوری از آناتاز به روتیل است، که حضور و افزایش ضخامت نانو خواش‌های مس باعث تسهیل این فرآیند از طریق افزایش زبری و افزایش مرزدانه‌ها می‌شود.

در این رابطه E_g , A , α , h , v , و n به ترتیب نشانگر ضریب جذب، ثابت پلانک، بسامد تابش، عدد ثابت معمولاً A ، E_g عددی است که مقدار آن به نوع نیمرسانا گاف انرژی و n عددی است که مقدار آن به نوع نیمرسانا بستگی دارد و برای نیمرسانا دی‌اکسیدتیتانیوم با گاف نواری غیر مستقیم مقدار آن ۴ است [۴۰]. بنابراین با رسم منحنی $(\alpha h v)^{1/2}$ بر حسب $h v$ می‌توان گاف انرژی را از طول از مبدأ خط مماس برمنحنی در لبه جذب محاسبه نمود. به منظور محاسبه گاف انرژی، منحنی‌های تاک حاصل برای نمونه‌ها در شکل ۱۰ آورده شده است. مقادیر گاف انرژی (E_g) در آورده شده است جدول ۲ دیده می‌شود که بر اثر عملیات گرمایی گاف انرژی از V در نمونه‌ی A_1 در 3.42 eV می‌شود.



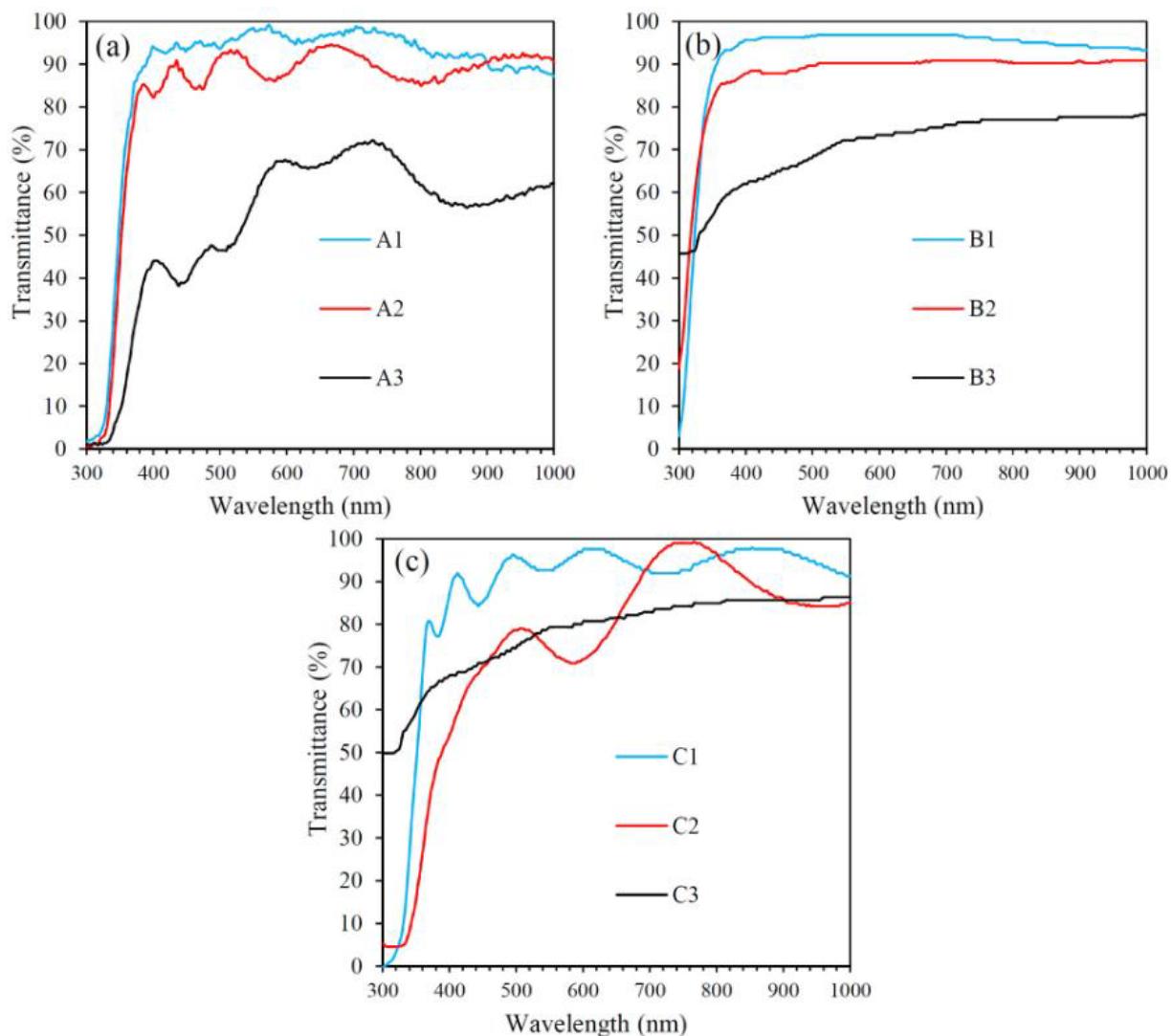
شکل ۱۰ منحنی تاک بدست آمده از طیف جذب نوری نمونه‌ها برای محاسبه گاف انرژی آنها.

جدول ۲ گاف انرژی نمونه‌ها محاسبه شده از طیف جذبی.

نمونه	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃
E_g (eV)	۳/۴۹	۳/۴۲	۳/۱۴	۳/۴۴	۳/۳۱	۳/۱۳	۳/۳۵	۳/۳۲	۳/۰۹

شود که ناشی از تبدیل فاز بلوری آناتاز به فاز روتیل در دی-اکسیدتیتانیوم است که حتی در غیاب نانو خوشه‌های مس نیز رخ می‌دهد، اما در حضور نانو خوشه‌های مس این کاهش در درصد عبور نور کمتر است. موضوع دیگری که با توجه به طیف عبور نمونه C₂ می‌توان مشاهده کرد، وجود یک نوار جذبی قوی در ناحیه مرئی طیف است که می‌تواند ناشی از ارتعاش‌های پلاسمون‌های سطحی نانو خوشه‌های مس باشد [۴۱].

برای بررسی بیشتر اثر حضور نانولایه میانی مس بر خواص نوری لایه‌های تهیه شده، طیف عبور نوری آنها نیز بررسی شد. طیف عبور نوری نمونه‌های تهیه شده در شکل ۱۱ نشان داده شده است. چنان که دیده می‌شود، وجود نانو خوشه‌های مس باعث افزایش عبور در ناحیه مرئی طیف شده و با افزایش ضخامت نانو خوشه‌های مس این افزایش در میزان عبور بیشتر می‌شود. علاوه بر ضخامت نانو خوشه‌های مس، عملیات گرمایی و افزایش دمای آن نیز باعث کاهش در عبور طیف تابشی می-



شکل ۱۱ طیف عبوری نمونه‌های تهیه شده.

- [3] Hoffmann M.R., Martin S.T., Choi W., Bahnemann D.W., "Environmental applications of semiconductor photocatalysis", *Chemical reviews* 95 (1995) 69-96.
- [4] Khakpoor A.A., Borjian R., Hoseinzade M., "Optical Properties Improvement TiO₂ Thin Films with Adding the Au, Ag or Cu Nanoparticles", *Int. Mater. Phys. J.* 1 (2013) 8-13.
- [5] Kavei G., Ahmadi K., Kavei A., "Self cleaning on photocatalyst basis of nano-crystalline TiO₂ thin film prepared by spray pyrolysis", *Transactions of the Indian Ceramic Society* 71 (2012) 31-38.
- [6] Nakaruk A., Kavei G., Sorrell C.C., "Synthesis of mixed-phase titania films by low-temperature ultrasonic spray pyrolysis", *Materials Letters* 64 (2010) 1365-1368.
- [7] Gao Y., Masuda Y., Seo W.-S., Ohta H., Koumoto K., "TiO₂ nanoparticles prepared using an aqueous peroxotitanate solution", *Ceramics International* 30 (2004) 1365-1368.
- [8] Byrne J.A., Fernandez-Ibanez P.A., Dunlop P.S.M., Alrousan D., Hamilton J.W.J., "Photocatalytic enhancement for solar disinfection of water: a review", *International Journal of Photoenergy* 2011 (2011).
- [9] Zaleska A., "Doped-TiO₂: a review", *Recent Patents on Engineering* 2 (2008) 157-164.
- [10] Lee Y.C., Hong Y.P., Lee H.Y., Kim H., Jung Y.J., Ko K.H., Jung H.S., Hong K.S., "Photocatalysis and hydrophilicity of doped TiO₂ thin films", *Journal of colloid and interface science* 267 (2003) 127-131.
- [11] Domaradzki J., Kaczmarek D., Prociow E.L., Borkowska A., Berlicki T., Sieradzka K., "Optical and electrical properties of TiO₂ doped with Tb and Pd", *Materials Science Poland* 26 (2008) 143-147.
- [12] Bensouici F., Bououdina M., Dakhel A.A., Tala-Ighil R., Tounane M., Iratni A., Souier T., Liu S., Cai W., "Optical, structural and photocatalysis properties of Cu-doped TiO₂ thin films", *Applied Surface Science* 395 (2017) 110-116.
- [13] Pongwan P., Wetchakun K., Phanichphant S., Wetchakun N., "Enhancement of visible-light photocatalytic activity of Cu-doped TiO₂ nanoparticles", *Research on Chemical Intermediates* 42 (2016) 2815-2830.
- [14] Colon G., Maicu M., Hidalgo M.C.s., Navio J.A., "Cu-doped TiO₂ systems with improved photocatalytic activity", *Applied Catalysis B: Environmental* 67 (2006) 41-51.

برداشت

وجود نانوخرشهای مس بر ریختشناسی سطح لایه‌های دی-اکسیدتیتانیوم اثر می‌گذارد و در نتیجه آن چگالش سطح لایه‌ها بیشتر، لایه‌ها متراکم‌تر و اندازه دانه‌ها کوچک‌تر شده و زبری سطح لایه‌ها بیشتر می‌شود. اگرچه وجود نانوخرشهای مس باعث تراکم و چگالش بیشتر سطح لایه‌ها شده است اما در ساختار فاز بلوری لایه‌ها و تبدیل فاز بلوری لایه‌ها بر اثر عملیات گرمایی تغییر مهمی ایجاد نمی‌کند. تنها تفاوت قابل اشاره تسهیل تبدیل فازی آنانたز به روئیل در حضور زیر لایه نانوخرشهای مس در عملیات گرمایی بوده و دلیل آن افزایش زبری و افزایش مرزدانه‌هاست.

تأثیر نانوخرشهای مس بر خواص نوری لایه‌ها قابل توجه است. وجود نانوخرشهای مس و افزایش ضخامت آن باعث کاهش قابل توجه در میزان جذب لایه‌ها و همچنین کاهش گاف انرژی لایه‌ها می‌شود و با کاهش کاف انرژی جذب نوری لایه‌ها در ناحیه مؤئی افزایش می‌یابد. وجود نانوخرشهای مس باعث افزایش عبور لایه‌ها می‌شود که دلیل آن رسانندگی بالای مس است که باعث تسهیل ترابری حامل‌های بار و تسريع فرآیند بازترکیبی الکترون-حرفه در فعالیت فتوکاتالیزوری دی-اکسیدتیتانیوم می‌شود. در کل، این برسی روش جدیدی را برای کنترل زبری و تبدیل فازهای بلوری و خواص نوری لایه‌های TiO₂ بر پایه استفاده از زیرلایه نانو خوش‌های ارائه می‌دهد که کنترل خواص زیرلایه بر خواص لایه نهایی تاثیر چشم‌گیری دارد. بدیهی است که آزمایش تعداد و ضخامت نانوخرشهای مس و رسانهای دیگر و همچنین عملیات گرمایی با زمان و دماهای متفاوت می‌تواند پیشنهاد مناسبی برای پژوهش‌های آینده باشد و باعث تکمیل اطلاعات به دست آمده شود.

قدردانی

بدین وسیله از پژوهشگاه مواد و انرژی به خاطر و پشتیبانی‌های آن قدردانی و سپاسگزاری می‌شود.

مراجع

- [1] Fujishima A., Zhang X., Tryk D.A., "TiO₂ photocatalysis and related surface phenomena", *Surface Science Reports* 63 (2008) 515-582.
- [2] Hashimoto K., Irie H., Fujishima A., "TiO₂ photocatalysis: a historical overview and future prospects", *Japanese journal of applied physics* 44 (2005) 8269.

- Benyoussef A., "Thickness effect on the optical properties of TiO_2 -anatase thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis: Experimental and ab initio study", International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 19467-19480.
- [25] Juma A., Oja Acik I., Oluwabi A.T., Mere A., Mikli V., Danilson M., Krunks M., "Zirconium doped TiO_2 thin films deposited by chemical spray pyrolysis", Applied Surface Science 387 (2016) 539-545.
- [26] Dongale T.D., Shinde S.S., Kamat R.K., Rajpure K.Y., "Nanostructured TiO_2 thin film memristor using hydrothermal process", Journal of Alloys and Compounds 593 (2014) 267-270.
- [27] Singh J., Khan S.A., Shah J., Kotnala R.K., Mohapatra S., "Nanostructured TiO_2 thin films prepared by RF magnetron sputtering for photocatalytic applications", Applied Surface Science 422 (2017) 953-961.
- [28] Rasoulnezhad H., Kavei G., Ahmadi K., Rahimipour M.R., "Combined sonochemical/CVD method for preparation of nanostructured carbon-doped TiO_2 thin film", Applied Surface Science 408 (2017) 1-10.
- [29] Taherniya A., Raoufi D., "The annealing temperature dependence of anatase TiO_2 thin films prepared by the electron-beam evaporation method", Semiconductor Science and Technology 31 (2016).
- [30] Herminghaus S., "Roughness-induced non-wetting", EPL (Europhysics Letters) 52 (2000) 165.
- [31] Irie H., Ping T.S., Shibata T., Hashimoto K., "Reversible control of wettability of a TiO_2 surface by introducing surface roughness", Electrochemical and Solid-State Letters 8 (2005) D23-D25.
- [32] Nolan N.T., Seery M.K., Pillai S.C., "Spectroscopic investigation of the anatase-to-rutile transformation of sol-gel-synthesized TiO_2 photocatalysts", The Journal of Physical Chemistry C 113 (2009) 16151-16157.
- [33] Ye J., Liu W., Cai J., Chen S., Zhao X., Zhou H., Qi L., "Nanoporous anatase TiO_2 mesocrystals: additive-free synthesis, remarkable crystalline-phase stability, and improved lithium insertion behavior", Journal of the American Chemical Society 133 (2010) 933-940.
- [34] Gribb A.A., Banfield J.F., "Particle size effects on transformation kinetics and phase stability in nanocrystalline TiO_2 ", American Mineralogist 82 (1997) 717-728.
- [15] Ganesh I., Kumar P.P., Annapoorna I., Sumliner J.M., Ramakrishna M., Hebalkar N.Y., Padmanabham G., Sundararajan G., "Preparation and characterization of Cu-doped TiO_2 materials for electrochemical, photoelectrochemical, and photocatalytic applications", Applied Surface Science 293 (2014) 229-247.
- [16] Karunakaran C., Abiramasundari G., Gomathisankar P., Manikandan G., Anandi V., "Cu-doped TiO_2 nanoparticles for photocatalytic disinfection of bacteria under visible light", Journal of colloid and interface science 352 (2010) 68-74.
- [17] Tryba B., Orlikowski J., Wróbel R.J., Przepiórski J., Morawski A.W., "Preparation and Characterization of rutile-type TiO_2 doped with Cu", Journal of Materials Engineering and Performance 24 (2015) 1243-1252.
- [18] Biyoghe Bi Ndong L., Ibondou M.P., Gu X., Lu S., Qiu Z., Sui Q., Mbadinga S.M., "Enhanced photocatalytic activity of TiO_2 nanosheets by doping with Cu for chlorinated solvent pollutants degradation", Industrial & Engineering Chemistry Research 53 (2014) 1368-1376.
- [19] Tsai C.-Y., Hsi H.-C., Kuo T.-H., Chang Y.-M., Liou J.-H., "Preparation of Cu-doped TiO_2 photocatalyst with thermal plasma torch for low-concentration mercury removal", Aerosol and Air Quality Research 13 (2013) 639-648.
- [20] Gondal M.A., Rashid S.G., Dastageer M.A., Zubair S.M., Ali M.A., Lienhard J.H., McKinley G.H., Varanasi K.K., "Sol-Gel Synthesis of $\{Au/Cu-TiO_2\}$ Nanocomposite and Their Morphological and Optical Properties", IEEE Photonics Journal 5 (2013) 2201908-2201908.
- [21] Zabihi F., Ahmadian-Yazdi M.R., Eslamian M., "Photocatalytic graphene- TiO_2 thin films fabricated by low-temperature ultrasonic vibration-assisted spin and spray coating in a sol-gel process", Catalysts 7 (2017).
- [22] Essalhi Z., Hartiti B., Lfakir A., Mari B., Thevenin P., "Optoelectronics properties of TiO_2 :Cu thin films obtained by sol gel method", Optical and Quantum Electronics 49 (2017).
- [23] Krupski K., Sanchez A.M., Krupski A., McConville C.F., "Optimisation of anatase TiO_2 thin film growth on $LaAlO_3(0\ 0\ 1)$ using pulsed laser deposition", Applied Surface Science 388 (2016) 684-690.
- [24] Ennaceri H., Boujnah M., Taleb A., Khaldoun A., Sáez-Araoz R., Ennaoui A., El Kenz A.,

- [38] Tauc J., "Absorption edge and internal electric fields in amorphous semiconductors", Materials Research Bulletin 5 (1970) 721-729.
- [39] Li S., Lin Y.-H., Zhang B.-P., Wang Y., Nan C.-W., "Controlled fabrication of BiFeO_3 uniform microcrystals and their magnetic and photocatalytic behaviors", The Journal of Physical Chemistry C 114 (2010) 2903-2908.
- [40] Wu G., Nishikawa T., Ohtani B., Chen A., "Synthesis and characterization of carbon-doped TiO_2 nanostructures with enhanced visible light response", Chemistry of Materials 19 (2007) 4530-4537.
- [41] Chan G.H., Zhao J., Hicks E.M., Schatz G.C., Van Duyne R.P., "Plasmonic properties of copper nanoparticles fabricated by nanosphere lithography", Nano Letters 7 (2007) 1947-1952.
- [35] Fagan R., Synnott D.W., McCormack D.E., Pillai S.C., "An effective method for the preparation of high temperature stable anatase TiO_2 photocatalysts", Applied Surface Science 371 (2016) 447-452.
- [36] Reyes-Coronado D., Rodríguez-Gattorno G., Espinosa-Pesqueira M., Cab C., de Coss R.d., Oskam G., "Phase-pure TiO_2 nanoparticles: anatase, brookite and rutile", Nanotechnology 19 (2008) 145605.
- [37] Won D.-J., Wang C.-H., Jang H.-K., Choi D.-J., "Effects of thermally induced anatase-to-rutile phase transition in MOCVD-grown TiO_2 films on structural and optical properties", Applied Physics A: Materials Science & Processing 73 (2001) 595-600.